

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 63-144513

(43)Date of publication of application : 16.06.1988

(51)Int.Cl.

H01L 21/205

(21)Application number : 61-291468

(71)Applicant : NKK CORP

(22)Date of filing : 09.12.1986

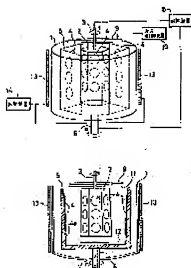
(72)Inventor : OMURA MASAKI
SAKAMA HIROSHI
ARAKI KENJI
KAMIO HIROSHI
SHIMA YOSHINOBU

(54) BARREL TYPE EPITAXIAL GROWTH DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To form the epitaxial film of high quality by a method wherein at least either of the first and the second susceptors is rotated, a radiant heat is generated between the materials to be treated which are located on the position opposing each other, and the flow of a reaction fluid is made uniform.

CONSTITUTION: The first susceptor such as cylindrical susceptor 2 of large square pole shape, for example, is droopingly provided by a shaft 3 in the bell jar 1 where a reaction fluid is made to flow in and exhausted. The second susceptor 5 is provided between the cylinder type susceptor 2 and the inner wall of the bell jar 1. Then, a plurality of wafers 4 are placed in longitudinal and lateral directions on the inner wall surface of the first and the second susceptors 2 and 5. Each of the wafers 4 has a mirror-faced surface, it functions as a radiant heat source, and the distribution of temperature can be made uniform. Then, as the susceptors 2 and 5 are rotated respectively, a reaction fluid flows uniformly on the surface of the wafers 4. Through these procedures, the epitaxial film having the uniform thickness and the uniform resistance value can be formed between each wafer 4.



⑫ Int. Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 昭和63年(1988)6月16日

H 01 L 21/205

7739-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

⑭ 発明の名称 パレル型エビタキシャル成長装置

⑮ 特 願 昭61-291468

⑯ 出 願 昭61(1986)12月9日

⑰ 発 明 者 大 村 雅 紀 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 日本鋼管株式会社
 ⑱ 発 明 者 坂 間 弘 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 日本鋼管株式会社
 ⑲ 発 明 者 荒 木 健 治 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 日本鋼管株式会社
 ⑳ 発 明 者 神 尾 寛 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 日本鋼管株式会社
 ㉑ 発 明 者 島 芳 延 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 日本鋼管株式会社
 ㉒ 出 願 人 日本鋼管株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号

明 細 書

1. 発明の名称

パレル型エビタキシャル成長装置

2. 特許請求の範囲

反応流体が随時流入するとともに排出する反応炉と、この反応炉内の垂直方向に設けられ複数の被処理体を縦横に載置する多角柱等の第1サセブタと、前記反応炉内で前記第1サセブタを囲う如く設けられ前記被処理体と対向する位置に被処理体を複数縦横に載置する第2サセブタと、これら第1および第2サセブタの少なくともいずれか一方を回転させる回転機構とを具備したことを特徴とするパレル型エビタキシャル成長装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、超LSI等の製造工程に用いられるパレル型エビタキシャル成長装置の改良に関する。

〔従来の技術〕

近年、集積回路は、高集積化、極微細化に伴って例えばMOS用の半導体基板(ウエハ)にエビ

タキシャル結晶を成長させてエビタキシャル層を形成することが多くなっている。そして、このエビタキシャル層の膜厚は半導体基板が大口径化するに伴って薄薄化している。そこで、このエビタキシャル成長の反応装置としては、水平反応管型、縦形ベルジャ型およびパレル型の3種類に分類され、そして最近開発されている減圧CVDを改造したホットウォール型がある。これら反応装置の概略構成は、高温状態の反応炉内に複数のウエハを載置するサセブタを置き、この反応炉内に四酸化シリコン(SiO₂)やシリラン等のガスである反応流体を流入させることによって各ウエハ表面にエビタキシャル層を形成させるものとなっている。

さて、上記パレル型エビタキシャル成長装置の改造型としてウエハに対して2方向から加熱を行って均一加熱を得るようにしたものがある。この装置の構成は高周波誘導コイルにより加熱するとともに、ベルジャ表面に貴金属コーティング膜を形成して金属コーティング膜からの輻射熱をウエ

ハの表面に放射させるようにしたものとなっている。

〔発明が解決しようとする問題点〕

ところで、エビタキシャル膜はその膜厚値および抵抗値を均一に保つことが高品質を得るために重要なことである。ところが、上記パレル型の装置では各ウエハごとの温度や同一ウエハ上に置けるチップを形成する部位ごとの温度を均一に制御することができず、温度分布が不均一となっている。この不均一性を補うためベルジャに金属コーティングを行う方法があるが、これも以下のような問題点がある。

また、ベルジャに形成した金属コーティング膜からの熱の輻射量はエビタキシャル成長の進行にともなって減少して温度を不均一化することとなっている。なお、金属コーティング膜はエビタキシャル処理を繰返すことにより熱疲労して劣化してしまう。さらに、流入される反応流体の流入量によっても温度が不均一となる。

一方、ウエハ製造処理量の面からみると、1回

の処理量が特に大口径のウエハになると少なくなり、ウエハのコスト高となる問題がある。

そこで本発明は、エビタキシャル膜厚や抵抗値等を均一化して高品質の薄膜が得られるパレル型エビタキシャル成長装置を提供することを目的とする。

〔問題点を解決するための手段〕

本発明は、反応流体が随時流入するとともに排出する反応炉と、この反応炉内の垂直方向に設けられ複数の被処理体を縦横に載置する多角柱等の第1サセブタと、前記反応炉内で前記第1サセブタを囲う如く設けられ前記被処理体と対向する位置に被処理体を複数縦横に載置する第2サセブタと、これら第1および第2サセブタの少なくともいずれか一方を回転させる回転機構とを備えて上記目的を達成しようとするパレル型エビタキシャル成長装置である。

〔作用〕

このような手段を備えたことにより、第1サセブタと第2サセブタとの少なくともいずれか一方

が回転し、これにより互に対向位置に置かれる被処理体間で輻射熱作用が起こるとともに反応流体の流れが均一化する。

〔実施例〕

以下、本発明の一実施例について図面を参照して説明する。

第1図はパレル型エビタキシャル成長装置の構成図であり、第2図はその断面構成図である。同図において1は円形又は楕円形状の円柱を有する石英等から成る反応炉（以下、ベルジャーと指称する）であって、このベルジャー1には随時四塩化シリコン（ SiCl_4 ）等の反応流体が流入するとともに排出している。このベルジャー1の内部には六角柱でかつ上面よりも下面の大きい第1サセブタとしてのシリンダ型サセブタ2がシャフト3でもって垂設され、このシリンダ型サセブタ2の各側面に被処理体としてのウエハ4が複数個各側面に所定の間隔をおいて全体からみて縦横方向に載置されている。さて、このシリンダ型サセブタ2とベルジャー1の内壁との間には、サセブ

タ2との間隔を比較的短くした状態で第2サセブタ5が設けられている。この第2サセブタ5はシリンダ型サセブタ2の各面と対向する各面を形成してシリンダ型サセブタ2を囲う如くの形状に形成されている。そして、この第2サセブタ5の内壁面にはウエハ4がそれぞれ支持端4aにより支持されて複数個全体から見て縦横方向に載置されている。なお、この第2サセブタ5の底部にはシャフト6が設けられ、このシャフト6の内部に反応流体の排出路7が形成されている。ところで、これらサセブタ2、5はそれぞれシャフト3、6を介して回転装置8によって少なくともいずれか一方が回転するものとなっている。すなわち、例えば、シリンダ型サセブタ2が回転装置8によって矢印（イ）方向に回転するとともに一方の第2サセブタ5が回転装置8によって矢印（ロ）方向に回転したり、また、シリンダ2、5のいずれか一方が停止し他方が上記方向（イ）（ロ）に回転するものとなっている。9は反応流体の噴出口を形成したノズル体であって、反応流体はガス制御

装置10によってその噴出量および噴出力等が制御されるものとなっている。具体的には、反応流体の流れをより均一化するために第3図に示す如く反射板11に小径の流れ孔11aを形成したり、また第4図に示す如く導入路11bを均一な噴射量および噴射力の得られるところに設けている。なお、ノズル体9は噴出口が各方向を向いて形成されていたり、またシリンダ型サセプタ2の回転と同期して回転して反応流体を均一にベルジャー1内に噴射するようになっている。さらに、第2サセプタ5の開口側および底面側には水またはガスにより冷却されている前記反射板11、12が表示しない支持体によって設けられている。また、ベルジャー1の外壁側には高周波誘導加熱コイル13が設けられて加熱装置14から高周波電流の供給を受けるようになっている。また、シリンダ型サセプタ2の内側にも高周波加熱コイルが設けられている。

このような構成であれば、各ウエハ4がシリンダ型サセプタ2およびこのサセプタ2を囲う如く

るところから反応流体は攪拌されて各ウエハ4面上に様に流れる。かくして、各ウエハ4面上におけるエピタキシャル反応の条件つまり温度分布が同一となるとともに反応流体の流れが一様となって各ウエハ4間で均一の膜厚でかつ均一の抵抗値をもったエピタキシャル膜が形成される。

このように上記一実施例においては、シリンダ型サセプタ2と第2サセプタ5とがそれぞれ回転して各ウエハ4が互いに輻射熱源として作用させるとともに反応流体を攪拌作用させる構成としたので、温度分布が同一となるとともに反応流体の流れが一様となって均一の膜厚でかつ均一の抵抗値をもったエピタキシャル膜が形成でき、しかも同一のウエハ4上における各部位ごとのバラツキも無くなって品質を均一化できる。これにより、エピタキシャル膜における欠陥、スリップ、微小欠陥等が減少する。また、各サセプタ2、5においてそれぞれ複数のウエハ4にエピタキシャル膜を形成できるので、1回の処理で多数のウエハ4にエピタキシャル膜を形成できる。

形成された第2サセプタ5にそれぞれ設置され、この状態でシリンダ型サセプタ2が矢印(イ)方向に回転するとともに第2サセプタ5が矢印(ロ)方向に回転する。そして、これと同時にガス制御装置10の制御によってノズル体9の各噴射出口から反応流体が同時ベルジャー1内に噴出され、これとともにこの反応流体が排出路7から排出される。また、誘導装置14から高周波電流が高周波誘導加熱コイル13に供給されてサセプタが所定温度に加熱される。このような状態にあれば、ベルジャー1の内部でエピタキシャル反応が進行して各ウエハ4の表面上にエピタキシャル結晶が成長する。さて、この時各サセプタ2、5にそれぞれ設置されている各ウエハ4はその表面が鏡面状となっているところから互いに輻射熱源として作用し、各サセプタ2、5の各ウエハ4間の温度分布を均一化する。さらに、熱は各反射板11、12においても反射されてベルジャー1内の温度がより均一化している。

一方、各サセプタ2、5がそれぞれ回転してい

なお、本発明は上記一実施例に限定されるものでなくその主旨を逸脱しない範囲で変形できる。例えば、各サセプタ2、5の回転方向は上記実施例以外に互いに同一方向に回転させてもよく、またいづれか一方のサセプタ2、5が停止状態にあっても上記実施例と同一の効果を導くことができる。また、ウエハ4はシリコン基板はもちろんのこと化合物半導体基板に対しても適用できる。

[発明の効果]

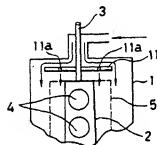
以上詳記したように本発明によれば、エピタキシャル膜厚およびその抵抗値を均一化して高品質のエピタキシャル膜が形成できるパレル型エピタキシャル成長装置を提供できる。

4. 図面の簡単な説明

第1図および第2図は本発明に係わるパレル型エピタキシャル成長装置の一実施例を示す構成図、第3図および第4図は本発明装置における反応流体の噴出手段の構成例を示す図である。

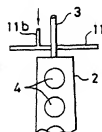
1…ベルジャー、2…シリンダ型サセプタ(第1サセプタ)、3、6…シャフト、4…ウエハ、

5…第2サセブタ、7…排出路、8…回転装置、
9…ノズル体、10…ガス制御装置、11、12
…反射板、13…高周波誘導加熱コイル、14…
加熱装置。

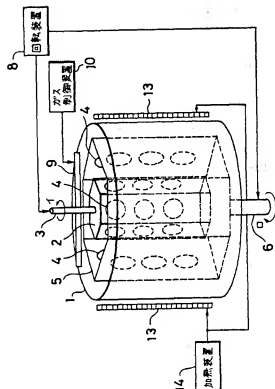


第3図

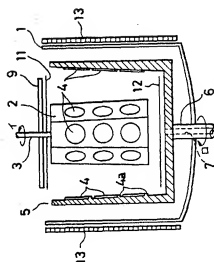
特許出願人 日本钢管株式会社



第4図



第1図



第2図